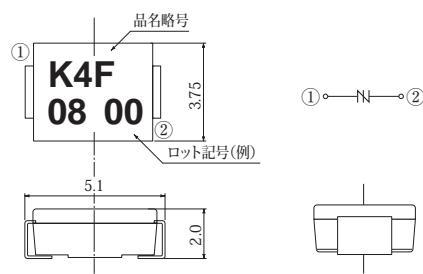


KU4F8

80V 40A

## ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Package : M2F



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

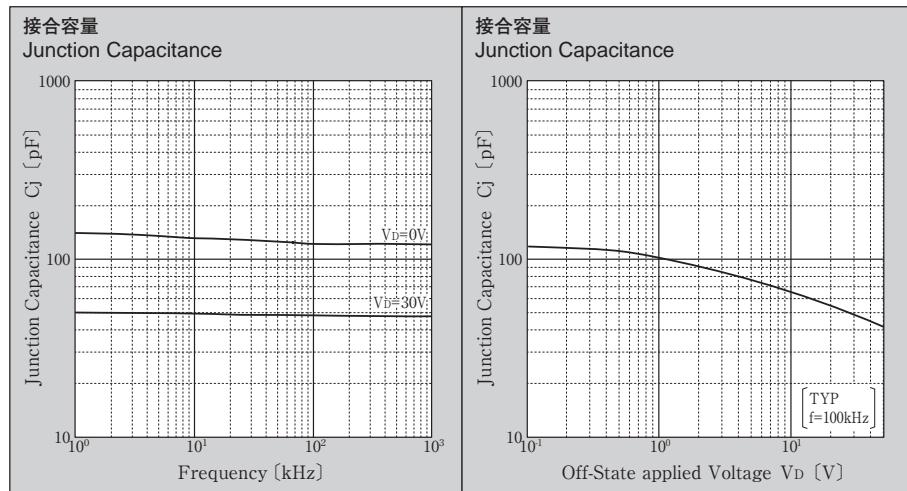
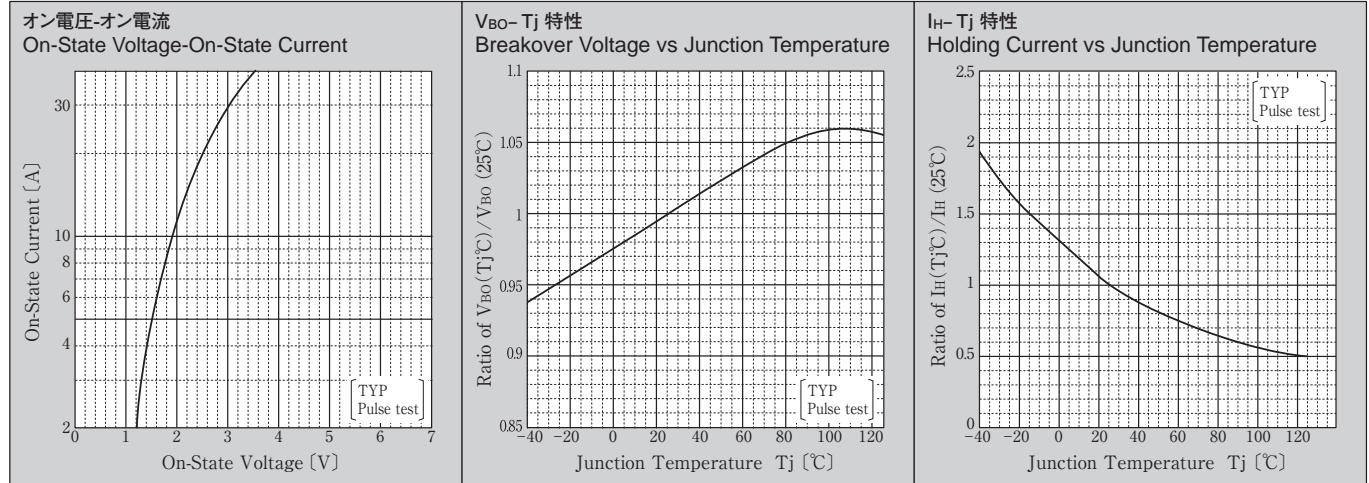
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_J = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>		-40~125	°C
接合部温度 Junction Temperature	T <sub>j</sub>		125	
せん頭オフ電圧 Max Off-State Voltage	V <sub>DRM</sub>		70	V
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>TSM</sub>	10/1000 μs 非繰り返し 10/1000 μs Non-repetitive	40	A
最大オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of MAX Off-State Voltage	dV/dt	V <sub>BO</sub> (min) × 0.63	1.5	KV/μs

●電気的特性  $T_c=25^\circ\text{C}$  Electrical Characteristics  $T_c=25^\circ\text{C}$  (指定のない場合  $T_J = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

ブレークオーバー電圧 Breakover Voltage	V <sub>BO</sub>	dV/dt = 8V/ms	ピークホールド法 Peak-hold	75~98	V
せん頭オフ電流 Off-State Current	I <sub>DRM</sub>	V <sub>D</sub> = 70V		MAX 10	μA
保持電流 Holding Current	I <sub>H</sub>	パルス測定 Pulse measurement		MIN 100	mA
オン電圧 On-State Voltage	V <sub>T</sub>	I <sub>T</sub> = 2A		MAX 3.0	V
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	f = 100kHz, V <sub>D</sub> = 30V, OSC = 20mVrms		MAX 100	pF

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.